



بررسی اثر غلظت بر خواص ساختاری و اپتیکی فیلمهای نازک اکسید منگنز به دست آمده از دو سل اسیدی و بازی

سارا پیشدادیان<sup>۱،\*</sup> و فرهاد اسمعیلی قدسی<sup>۲</sup>

۱- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، گروه فیزیک، شاهرود، ایران
۲- گروه فیزیک دانشگاه گیلان، رشت

تاریخ ثبت اولیه: ۱۳۸۹/۰۶/۲۸، تاریخ دریافت نسخه اصلاح شده: ۱۳۸۹/۰۸/۱۲، تاریخ پذیرش قطعی: ۱۳۸۹/۱۲/۱۷

### چکیدہ

در این پژوهش فیلمهای نازک اکسید منگنز به کمک روش سل- ژل و با تکنیک غوطهوری تهیه شدند و تاثیر تغییر غلظت بر روی خواص ساختاری و اپتیکی فیلمهای نازک اکسید منگنز که به کمک IR خشک شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. این نمونهها از دو نوع سل اسیدی و بازی و با پیش مادههای اصلی استیل استونات منگنز و استات منگنز ۴ آبه تهیه شدند. لایههای به دست آمده از سل بازی، به دلیل ویسکوزیته بالایشان، ضخامت بیشتری داشتند. خواص ساختاری و مورفولوژی فیلمهای نازک اکسید منگنز به کمک نمودارهای XRD و تصاویر AFM مورد بررسی قرار گرفتند. خواص اپتیکی این فیلمها با استفاده از طیف تراکسیل آنها تعیین شد. ثوابت اپتیکی و گاف انرژی نیز به کمک مینیممسازی طیف تراکسیل تولید شده نسبت به دادههای تجربی محاسبه گردید.

*واژههای کلیدی*: سل- ژل، فیلمهای نازک، اکسید منگنز، ثوابت اپتیکی، خواص ساختاری.

### ۱– مقدمه

اکسید منگنز یک اکسید چند گانه است و در پنج فرم اکسیدی Mn<sub>2</sub>O<sub>7</sub> ،MnO ،Mn<sub>3</sub>O<sub>4</sub> ،Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ،MnO<sub>2</sub> یافت میشود. از میان این اکسیدها، MnO<sub>2</sub> پایدارترین حالت

اکسیدی این ماده بوده و در واقع سایر اکسیدهای منگنز از انجام عملیات حرارتی بر روی این اکسید به دست میآیند. در میان اکسیدهای متنوع منگنز تنها Mn<sub>2</sub>O7 به دلیل نقطه ذوب پایین و قابلیت انفجار بالای آن به صورت فیلم نازک قابل تولید نمیباشد. این فیلمها به دلیل خواص

<sup>\*</sup> **عهدهدار مكاتبات:** سارا پیشدادیان

**نشانی:** شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود

تلفن: ۲-۲۳۹۴۵۳۰-۲۷۳، دورنگار: ۳۳۹۴۵۴۸-۳۷۳۰، پستالکترونیکی: spishdadian@iau-shahrood.ac.ir

بسیار جالب الکتروکرومیکی، مغناطیسی و سنسوری در طی سالهای اخیر مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است. خواص جالب این ماده سبب ایجاد کاربردهای متنوعی برای این ماده شده است که در این میان میتوان به باتریهای قابل شارژ، پیلهای الکتروشیمیایی، سنسورهای شیمیایی و رطوبتی، شبه خازنهای اکسایشی، فیلترهای اپتیکی فعال، ذخیرهساز دادههای کامپیوتر و نمایشگرها، پنجرهها و آینههای زیبا اشاره کرد.

روش های مختلفی جهت تولید لایه های نازک اکسید منگنز وجود دارد که از مهمترین آنها می توان به روش اسپری [۱]، تبخیر حرارتی [۲]، ALD [۳]، روش آندی [۴]، الکتروشیمیایی [۵] و روش سل- ژل [۶،۷] اشاره کرد. در میان تمامی این روش ها، علی رغم کیفیت بالای لایه های تولید شده به روش سل- ژل و قیمت مناسب آن جهت تولیدات صنعتی، تهیه و بررسی خواص اپتیکی این ماده به کمک روش سل- ژل به ندرت انجام گرفته است. همچنین با وجود خواص جالب اپتیکی این ماده نظیر پوشش های الکتروکرومیکی، خواص اپتیکی این ماده در حالت کلی نیز به صورت گسترده مورد بررسی قرار نگرفته است. فیلم های نازک اکسید منگنز تهیه شده به روش سل- ژل دارای سطح یکنواخت و با تخلخل نسبتا بالایی میباشند.

در این تحقیق ضخامت و ثوابت اپتیکی (ضریب شکست و خاموشی) و گاف انرژی اپتیکی فیلمهای نازک اکسید منگنز تهیه شده با روش سل- ژل محاسبه گردیدند. این ثوابت اپتیکی به کمک طیف تراگسیل نمونهها و بر مبنای تئوری بهینهسازی نامقید و نرم افزار PUMA مورد محاسبه قرار گرفت.

### ۲- فعالیتهای تجربی

## MnO<sub>2</sub> تهیه فیلم های نازک -1-۲

در این پژوهش، فیلمهای نازک اکسید منگنز از دو نوع سل اسیدی و بازی تهیه شد. سل بازی از ترکیب استات منگنز ۴ آبه به عنوان پیش ماده اصلی و ترکیبی از ۲-متوکسی اتانول به عنوان حلال و مونواتانول آمین (MEA) به دست آمد. ترکیب این مواد در دمای C

به مدت ۲ ۲ هم زده می شد. پس از ۲۴ ساعت ایجینگ و انجام عملیات فیلترسازی، سلی به رنگ قه وه ای تیه به گام، دست آمد. به کمک انجام عملیات بهینه سازی گام به گام، نسبت ۱ = MEA/AcMn و غلظت ۲ ۵/۰ به عنوان بهترین نسبت جهت تولید لایه هایی با کیفیت خوب انتخاب شد. سل اسیدی هم از ترکیب استیل استونات منگنز به عنوان پیش ماده اصلی و ۱ - بوتانول به عنوان حلال و اسید استیک به عنوان کاتالیزور تشکیل شده بود. ترکیب این مواد بدون حضور آب و حرارت به مدت حداقل h ۵ هم زده می شد. پس از انجام عملیات فیلترسازی، سلی به رنگ قهوه ای تیره به دست می آمد. این سل احتیاج به ایچینگ خاصی نداشت.

بهترین نسبت به دست آمده در این سل نیز عبارت بودنـد از نسبت: ۳ به ۱= اسـید اسـتیک/۱-بوتـانول و غلظـت M ۲/۰. به منظور بررسی اثر تغییر غلظت بر خـواص اپتیکی فیلمهای نازک اکسید منگنز، نمونهها با ثابت نگـه داشـتن نسبت ۲ = MEA/AcM و تغییر غلظت استات منگنز در سل بازی، با نسبت غلظت M ۲/۰، M ۵/۰، M ۶/۰و M ۵/۷۰ تولیـد شـد. بـه دلیـل کیفیـت نامناسب سلهای تولیدی در غلظتهای کمتر از M ۳/۰ و بیشتر از M/ ۵/۷۰، از بررسی آنها صرف نظر شد. به منظور بررسی اثر غلظت در سل های اسیدی نیـز بـا ثابـت نگـه داشـتن نسبت ۱- بوتانول به اسید اسـتیک برابـر ۳ بـه ۱ و تغییـر غلظت استیل استونات منگنز سـلهـای متفـاوتی را تهیـه کردیم.

این سلها در غلظتهای مختلفی از جمله M ۰۰/۳ M ۸/۰ و M ۶/۰ تهیه شدند. لازم به ذکر است که سلهای با غلظت کمتر از M ۳/۰ و بالاتر از M ۶/۰ از کیفیت خوبی برخوردار نبودند. جهت بررسی اثر تغییر غلظت در هر دو سل، نمونههایی با تعداد ۹ بار لایه نشانی با سرعت است که کلیه نمونههایی با تعداد ۹ بار لایه نشانی با سرعت I cm/min از هر دو نوع سل تهیه شدند. لازم به ذکر است که کلیه نمونهها پس از هر بار لایه نشانی توسط لامپ IR متصل شده بر روی دستگاه غوطه وری- چرخشی واقع در آزمایشگاه سل-ژل دانشکده علوم دانشگاه گیلان به مدت مای ۲۰ min کلیه نمونهها در دمای C ۰۳ به مدت یک ساعت باز پخت (annealing)



شکل ۱: دستگاه پوشش دهنده غوطهوری – چرخشی واقع در دانشگاه گیلان.

#### ۲-۲- محاسبات

در این تحقیق از آنالیز XRD جهت بررسی ساختار کریستالی فیلمهای نازک اکسید منگنز استفاده گردید. بررسی مورفولوژی سطح این لایهها نیز در حالت کلی به كمك آناليز AFM انجام شد. طيف تراگسيل اين نمونهها نیز توسط دستگاه (UV-vis ( CARY 100 Scan به دست آمد. ثوابت اپتیکی این نمونه ها نیز با استفاده از بهینه سازی نا مقید و به کمک نرم افزار پوما انجام گرفت. از جمله مدلهایی که میتوان در صورت عدم وجود نقاط اکسترمم در طيف تراگسيل فيلم، به منظور استخراج ثوابت اپتیکی یک فیلم نازک، مورد استفاده قرار داد روش بهینهسازی است که توسط چامبولیرون و همکارانش، با در نظر گرفتن برخی محدودیتهای فیزیکی که در مورد نیمه هادیها و عایقها در ناحیه پراکندگی معتبر است، ارائه شده است. اساس این روش بر این پایه است که با توجه به محدوده تغییراتی که برای ثوابت اپتیکی k ،n و d وجود دارد، در هر طول موج خاص با استفاده از معادله ۱ جوابی به صورت  $T(\lambda_i, n_i, s, d)$  به دست می آید.

$$T_M = \frac{Ax}{B - Cx + Dx^2} \tag{1}$$

سپس با در نظر گرفتن برخی از مدلهای برازشی همانند کوشتی مجموعیه جیوابهایی را که به ازای آنها، عبارت  $\sum_{i=1}^{N} [T_i - T(\lambda_i, n_i, s, d)]^2$  عبارت  $\sum_{i=1}^{N} [T_i - T(\lambda_i, n_i, s, d)]^2$  انتخاب میشوند. در این عبارت  $T_i$  مقدار تجربی تراگسیل

مربوط به i امین طول موج است  $[\Lambda]$ . روش کار ما در این پروژه بدین صورت است که پس از به دست آوردن طیف تراگسیل و مقدار عبور در هر طول موجی، مقادیر ضرایب شکست (  $2.5 \le n \le 2.5$ ) و خاموشی (  $1 \le k \ge 0$ ) در یک محدوده خاصی اختیار میشوند. با در نظر گرفتن یک ضخامت تقریبی، مقدار عبور را محاسبه کرده و نمودار آن را رسم میکنیم. دو منحنی تراگسیل تجربی و تئوری به دست آمده را با استفاده از مدل کوشی برازش کرده و با در نظر گرفتن حداقل خطا، مقدار دقیق ضخامت و سایر ثوابت اپتیکی در هر طول موج خاصی به دست میآید.

# ۳- نتایج و بحث

### MnO₂ مشخصهیابی فیلمهای نازک -1-۳

حالت اکسیدی پایه در میان اکسیدهای مختلف منگنز، دی اکسید منگنز میباشد. سایر اکسیدهای منگنز از اثر عملیات حرارتی بر روی این اکسید و تحت دماهای مختلف به دست می آیند. به طور تقریبی این رابطه دمایی را می توان به صورت رابطه ۲ نمایش داد. شکل ۲ نمودار XRD فیلم های MnO<sub>2</sub> به دست آمده از سل اسیدی را نشان مىدهد. اين فيلمها داراى ساختار آمورف بودند. اين نمونهها تحت دمای C<sup>o</sup>C و به مدت ۱ ساعت تحت عملیات بازیخت قرار گرفتند. از آنجایی که در این پروژه از زیر لایههای شیشهای استفاده شده بود و این زیرلایهها تحمل دماهای بالاتر از C° ۵۰۰ را ندارد، لذا جهت تهیه و بررسی سایر اکسیدهای منگنز به ساخت پودر و انجام عملیات حرارتی بر روی آنها اقدام شد. به منظور تهیه این یودرها، سل اسیدی به مدت ۵ ساعت تحت دمای C<sup>o</sup>C هم زده شد تا ژل یکنواختی به دست آمد. سپس این ژلها در دماهای C<sup>o</sup>C و ۸۰۰–۶۰۰ به مدت ۴ ساعت تحت عملیات حرارتی قرار گرفت و پودر قهوهای روشن Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub> و قهـوهای سـوخته Mn<sub>3</sub>O<sub>4</sub> بـه دسـت آمـد در شـکل ۳ ساختارهای کریستالی به دست آمده در تطابق کامل با سایر گزارشات ارائه شده بود [۱٬۶٬۹٬۱۰]. به کمک طیفهای XRD به دست آمده از پودرهای تولیدی شکل ۵، ۶ و ۷ و به کمک قانون شرر، اندازهی دانهها به ترتیب ۲۵، ۱۸ و ۴۷ نانومتر برای نمونههای به دست آمده در دماهای ۶۰۰، ۸۰۰ و C<sup>o</sup> ۱۰۰۰ محاسبه شد.

R

$$MnO_2 \xrightarrow{500^\circ C} Mn_2O_3 \xrightarrow{900^\circ C} Mn_3O_4 \xrightarrow{1700^\circ C} MnO$$



شکل ۲: نمودار XRD مربوط به فیلمهای باز پخت شده در دمای C°۰۳۰۰.



شکل ۳: تصاویری از پودرهای تهیه شده،الف) C° ۳۰۰ (MnO<sub>2</sub>)، ب) C° ۶۰۰ (Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)، ج) C° ۸۰۰ (ترکیبی از دو فاز Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub> و Mn<sub>2</sub>O<sub>4</sub>) د) C° ۱۰۰۰ (Mn<sub>3</sub>O<sub>4</sub>).

(۲)

R



شکل ۵: نمودار XRD پودرهای تهیه شده در  $^{9}$  ۶۰۰ (Mn $_{2}O_{3})$ ).





شکل ۶: نمودار XRD پودرهای تهیه شده در ℃ ۸۰۰ (ترکیبی از دو فاز Mn2O3 و Mn3O4 ) صفحات کریستالی مشخص شده مربوط به ساختار Mn3O4 است.



شکل ۷: نمودار XRD پودرهای تهیه شده در C<sup>°</sup> ۱۰۰۰ (Mn<sub>3</sub>O<sub>4</sub>).



میکرومتر و ب) در ابعاد۲۰×۲۰ میکرومتر.

برای تهیه پودر از سل بازی هم اقدام به تهیه ژل از سل مورد نظر کردیم. به منظور تهیه پودر، ابتدا سل مورد نظر را به مدت ۳۳ ساعت در دمای <sup>O</sup><sup>o</sup> ۱۰۰ همزدیم تا ژل یک دست و مناسبی به دست آمد. اما متاسفانه شرایط تهیه پودر مناسب از این سل فراهم نبود. از این ژل به دلیل واکنش سریع آن با اکسیژن هوا و در نتیجه سوختن آن، نتوانستیم پودری تهیه کنیم. تهیه این پودر احتیاج به

تکنیک خاص ویا کوره مجهز به محفظه خلاء و یا حضور گازهای دیگری به منظور جلوگیری از ورود هوا و از بین رفتن ژل مورد نظرداشت.

در حالت کلی فیلمهای نازک اکسید منگنز دارای ساختار متخلخلی می باشند. تصاویر میکروسکوپ نیرو اتمی (AFM) به دست آمده از نمونهها به خوبی گویای این مطلب می باشد (شکل ۸). با توجه به این تصاویر کاملا مشخص است که نمونههای به دست آمده دارای ساختاری یکنواخت و متخلخل می باشند. همانگونه که مشاهده می شود نمونههای به دست آمده از کیفیت بسیار خوبی برخوردار بودند. این مساله به این معنی است که سطح نمونهها کاملا یکنواخت، بدون ترک، خش و ناخالصی تهیه شده است.

MnO<sub>2</sub> تغییر غلظت در فیلمهای نازک -۲-۳

به منظور بررسی اثر تغییر غلظت بر خواص ایتیکی فیلمهای نازک اکسید منگنز، نمونه ها با ثابت نگه داشتن نسبت MEA/AcMn = r = ۱ و تغییر غلظت استات منگنز در سل، با نسبت غلظت M ،۰/۳ M ۰/۳ M ۰/۵ M ۰/۶ M و VA M ، تولید شد. به دلیل کیفیت نامناسب سلهای تولیـدی در غلظـتهـای کمتـر از M ۳/۰و بیشـتر از ۰/۷۵ M از بررسی آنها صرفنظر شد. ساختار پلیمری سلها به علاوه تغییر غلظـت، در افـزایش گرانـروی بسـیار موثر است؛ با افزایش غلظت طول زنجیرههای پلیمری بلندتر شده و در نتیجه گرانروی نیز افزایش می یابد. اگرچه با افزایش غلظت پیش ماده اصلی، محصولات جانبی نیز به اندازه محصولات نهایی افزایش می یابند اما در واقع نتیجه مطلوب از رشد زنجیرههای پلیمری حاصل می شود. شکل ۹ تغییرات طیف تراگسیل عمودی نمونهها را با تغییر غلظت نشان میدهد. افزایش غلظت منجر به تولید فیلمهایی با ضخامت بالاتر شد که این افزایش ضخامت سبب کاهش عبور در فیلمها گردید. شکل ۱۰ و ۱۱ تغییرات ضریب شکست و خاموشی را در نمونههای به دست آمده از سل بازی را تحت تغییر پارامتر غلظت نشان میدهد. با افزایش غلظت، شاهد افزایش ضخامت و کاهش تخلخل هستیم. علاوه بر افزایش ضخامت، رشد شاخههای پلیمری نیز در کاهش هر چه بیشتر تخلخل موثر بوده و ۷۱

لذا ضرایب خاموشی و شکست نیز افزایش مییابند. اکسید منگنز دارای گاف انرژی غیر مستقیم میباشدکه مقادیرآن از برونیابی منحنی <sup>½</sup>(αhv) بر حسب انرژی فوتون به دست میآید.







شکل ۱۰: تغییرات ضریب شکست در نمونههای به دست آمده از سل بازی با تغییر غلظت.

شکل ۱۲ نمودار تغییرات گاف انرژی اپتیکی نمونههای به دست آمده را نشان میدهد. تغییرات غلظت از جمله تغییرات شیمیایی است که ساختار ماده را تحت تأثیر قرار

میدهد و در نتیجه تغییری اندک در میزان گاف انـرژی را به دنبال دارد، همچنین این تغییر اندک، به کمک روابط حاکم در ناحیه جذب قوی نیز قابل توجیه است. در ناحیه جذب قوى با توجه به رابطـه (x=exp(-αd بـراى محاسـبه یارامتر α نیازمند به محاسبه یارامتر x ملی باشیم. این  $x \approx \frac{(n + 1)^{3} (n + s)}{16 n^{2} s} T_{0}$  يارامتر نيز بـه صورت  $x_{0}$ تعریف می شود. واضح است کـه ایـن رابطـه بـه مجـذور ضریب شکست و تغییرات تراگسیل در ناحیه جـذب قـوی وابسته است. در واقع اگر در ناحیه جذب قوی عدم رویه هم افتادگی در طیفهای تراگسیل نمونهها و تغییرات عمده ضریب شکست را داشته باشیم، تغییر پارامتر x و در نتیجه یارامتر α کاملا بدیهی است که این مساله سبب تغییر در میزان گاف انرژی ایتیکی نمونهها خواهد شد. این مساله در کنار سایر مطالب ذکر شده توضیح دهنده نحوه تغییرات گاف انرژی نمونههای به دست آمده می باشد. این مقادیر با سایر گزارشات همخوانی داشت [۹،۱۰]. جدول ۱ مقایسه خواص ایتیکی فیلمهای ناز ک MnO<sub>2</sub> را با تغییر غلظت در سلهای بازی نشان میدهد.



۳-۳- تغییر غلظت در سل اسیدی و بررسی اثر آن بر خواص اپتیکی فیلمهای نازک 2 MnO سل استفاده شده در این قسمت از سه پیش ماده اصلی استیل استونات منگنز، اسید استیک و ا- بوتانول تشکیل شده بود.

R



شکل ۱۲: تغییرات گاف انرژی اپتیکی در نمونههای به دست آمده از سل بازی با تغییر غلظت.

غلظت	سرعت غوطه وری (cm/min)	تعداد غوطه وری	دمای باز پخت	n	k	d(nm)	Band gap (eV)
۰/۳M	11	٩	°C ۳	1/88	•/•٢١	181	۱/۵۳
۰/۵M	11	٩	°C ۳۰۰	۱/۶۸	•/•٣٣	180	١/۴٩
۰/۶M	11	٩	°C ۳	١/۶٩	•/•٣٧	188	۱/۴۸

در nm ۵۵۰ nm.	ں <b>غلظت</b> د	افزايش	آمدہ با	به دست	مقادير	۱: مقایسه	جدول ا
---------------	-----------------	--------	---------	--------	--------	-----------	--------

لازم به ذکر است که سلهای با غلظت کمتر از M /۰ کیفیت خوبی داشتند اگر چه این سلها از ویسکوزیته بالایی برخوردار نبودند، اما تأثیر این عامل به عنوان یکی از عوامل موثر در افزایش ضخامت شایان ذکر میباشد. شکل ۱۳ تغییرات طیف تراگسیل عمودی نمونههای به دست آمده از سل اسیدی را با تغییر غلظت نشان میدهد.

R

به منظور بررسی اثر غلظت در سلهای اسیدی با ثابت نگه داشتن نسبت ۱- بوتانول به اسید استیک برابر ۳ به ۱ و تغییر غلظت استیل استونات منگنز سلهای متفاوتی را تهیه کردیم. این سلها در غلظتهای مختلفی از جمله M ۲/۰۰ M ۵/۰ و M ۶/۲ تهیه شدند.

همانگونه که ملاحظه میشود با افزایش ضخامت از میزان عبور فیلمها کاسته شده است.



شکل ۱۳: تغییرات طیف تراگسیل عمودی نمونههای به دست آمده از سل اسیدی با تغییر غلظت.



شکل ۱۴: تغییرات ضریب شکست در نمونههای به دست آمده از سل اسیدی با تغییر غلظت.

شکل ۱۴ و ۱۵ تغییرات ضریب شکست و خاموشی را در نمونههای به دست آمده از سل اسیدی را تحت تاثیر پارامتر غلظت نشان میدهند. همانگونه که مشاهده میشود با افزایش غلظت و به تبع آن افزایش ضخامت، کاهش تخلخل را در فیلمها خواهیم داشت. علی رغم افزایش ضخامت، رشد ذرات کلوئیدی نیز در کاهش هر چه بیشتر تخلخل موثر بوده و لذا ضرایب خاموشی و شکست نیز افزایش خواهند یافت. تغییرات گاف انرژی این نمونهها در شکل ۱۶ نشان داده شده است. همان طور که ذکر شد به دلیل تغییر پارامتر شیمیایی غلظت، تغییر در گاف نواری امری بدیهی به نظر می رسد.



شکل ۱۵: تغییرات ضریب خاموشی در نمونههای به دست آمده از سل اسیدی با تغییر غلظت.

این مسأله به خوبی توسط عدم روی هم افتادگی طیف تراگسیل نمونهها در ناحیه جذب قوی نیز قابل توضیح میباشد. همانگونه که ملاحظه میشود تغییرات گاف انرژی در این نمونهها زیاد نیست. همچنین این مقادیر به دلیل تغییر در نوع سل با مقادیر به دست آمده در بخش قبل متفاوت میباشند. جدول ۲ مقایسه خواص اپتیکی فیلمهای نازک 20M را با تغییر غلظت در سلهای اسیدی نشان میدهد.

R



شکل ۱۶: تغییرات گاف انرژی اپتیکی در نمونههای به دست آمده از سل اسیدی با تغییر غلظت.

غلظت	سرعت غوطه وری (cm/min)	تعداد غوطه وری	دمای باز پخت	n	k	d(nm)	Band gap (eV)
۰/۳M	11	٩	°C	1/88	۰/۰۲۱	181	۱/۵۳
			۳۰۰				
∙/۵M	))	٩	°C ۳	۱/۶۸	•/•٣٣	180	1/49
۰/۶M	11	٩	°C ۳	۱/۶۹	•/•٣٧	188	١/۴٨

جدول ۲: مقایسه مقادیر به دست آمده با افزایش غلظت در nm.

۴-۳- تغییر غلظت در سل اسیدی و بررسی اثر آن بر خواص ساختاری فیلمهای نازک 2MnO

به منظور بررسی خواص ساختاری این لایهها به بررسی تصاویر AFM به دست آمده از این نمونهها می پردازیم. به کمک تصاویر AFM میتوان جزئیات بیشتری را از نحوه چینش دانهها، اندازه دانهها، حفرهها، شیارها و جزئیات کاربردی فراوان دیگری به دست آورد. این تصاویر اطلاعاتی از فاکتورهای زبری را در اختیار ما قرار میدهد.

به کمک این اطلاعات به درستی میتوان نحوه تغییر ضرایب اپتیکی را با تغییر ضخامت و سایر پارامترهای متغیر دیگر توضیح داد.

شکل ۱۹ تصاویر فاز را در مقیاس ۵×۵ میکرومتر در هر دو نمونه نشان میدهد. این تصاویر با استفاده از تغییرات ولتاژی که بین مولکولهای موجود در سطح نمونه و نوک پروب میکروسکوپ نیروی اتمی به وجود آمده تهیه شده است.

همچنین به کمک فاکتورهای زبری می *ت*وان کاهش و یا افزایش ضخامت را در سطح توضیح داد. تجربه نشان داده است که نمی *ت*وان رابطهای کلی برای تغییرات ضریب شکست فیلمهای نازک بر حسب تغییرات ضخامت فیلمها پیدا کرد. در واقع می توان ضریب شکست را به طور قطع تابعی از تخلخل فیلمها دانست. این رابطه به صورت زیر تعریف می شود:

در صد تخلخل=
$$(1 - \frac{n^2 - 1}{n_d - 1}) \times 1 \cdots$$
 (۳)

که در آن ا<sup>n</sup> ضریب شکست یک فیلم بدون حفره است. این مقادیر در یک طول موج خاص ثبت میشوند. به ازای افزایش تخلخل، ضریب شکست کاهش مییابد و بالعکس. حال اگر با افزایش ضخامت فیلم به میزان تخلخل آن افزوده شود، ضریب شکست کاهش و اگر تخلخل کاهش یابد، ضریب شکست افزایش مییابد. بنابراین در توضیح دقیقتر آنالیزهای به دست آمده مبنی بر افزایش یا کاهش ضرایب اپتیکی با ضخامت، دانستن فاکتورهای زبری و به تبع آن اطلاع از میزان تخلخل لایههای به دست آمده بسیار مهم میاشد. پارامترهای زبری مورد بررسی قرارگرفته عبارتند از:

۱۰ نقطـه از سـطح محاسـبه مـی شـود (۵ مینـیمم و ۵ ماکزیمم).

همانطور که در بخش قبل ملاحظه شد با افزایش غلظت سل، ضخامت افزایش یافت و همچنین افزایش ضرایب شکست و خاموشی نیز مشاهده گردید. به نظر میآید که این افزایش به دلیل کاهش تخلخل و افزایش پکیدگی در فیلمها است. این مساله به خوبی توسط تصاویر AFM و پارامترهای زبری محاسبه شده تایید شد. شکل ۱۷ تصاویر توپوگرافی در ابعاد ۵×۵ میکرومتر رادر هر دو نمونه M ۳/۰ و ۵/۵۸ نشان میدهد. همان گونه که ملاحظه میشود نمونه به دست آمده از سل ۲۳ /۰ دارای یکنواختی کمتر

و شیارهای بیشتری میباشد. افزایش نقاط تیره با کاهش غلظت در این مقیاس نشانگر افزایش چگالی شیارهای موجود در ساختار لایه میباشد. لازم بذکر است که مقیاسهای تنظیم شده در هر قسمت برای هر دو تصویر ثابت میباشد. جدول ۳ مقایسهای از پارامترهای زبری محاسبه شده در این مقیاس میباشد. شکل ۱۸ نیز تصاویر محاسبه شده در این مقیاس میباشد. شکل ۱۸ نیز تصاویر توپوگرافی در حالت سه بعدی در ابعاد ۵×۵ میکرومتر را در هر دو نمونه ۲۸ / و ۲۵ / نشان میدهد. به کمک این تصاویر به راحتی میتوان سطح فیلمها را مورد آنالیز قرار داد. رشد دانهها و یکنواختی سطح به خوبی با افزایش غلظت در تصاویر مشاهده میشود. با افزایش غلظت سطح فیلمها یکنواختتر شده و ترکها و شیارها نیز کمتر شدهاند. کاهش حفره در سطح نیز با افزایش غلظت به

[ 24.3 nm ] 36.6 nm





شکل ۱۷: تصاویر توپوگرافی در ابعاد ۵×۵ میکرومتر الف) M ۲/۰ و ب) M ۵/۰.

محاسبه	ز د ی	های	بار امتر	;1	مقابسهاي	۳:	حدول
محصب	ربرى	سى.	پار اسر	ינ	سايسه،	• •	بتكون

شده در این مقیاس ۵×۵ میکرومتر.									
غلظت	S <sub>a</sub> (nm)	S <sub>q</sub> (nm)	S <sub>v</sub> (nm)	S <sub>c</sub> (pm)	S <sub>m</sub> (pm)				
۰/۳ M	<b>१/•</b> ९	١/۶٠	۶/۱۸	۲۵/۳	۵/۹۸				
۰/۵ M	١/• ٢	١/٣١	۱/۸۱	९/४۶	۴/۵۴				



شکل ۱۸: تصاویر توپوگرافی در حالت سه بعدی در ابعاد۵×۵ میکرومترالف) ۲۵ /۳ ۳ با م۸/۰ و ب) ۸۱ /۰

همچنین به کمک این تصاویر می توان پروفیل میانگین نقاط عمود بر خط مقطع طولی را نیز رسم کرد شکل ۲۰. به کمک این نمودارها می توان نحوه تغییرات پستی و بلندیهای سطح را تشخیص داده و معیاری از یکنواختی سطح داشت. همان طور که ملاحظه می شود با افزایش غلظت، سطح یکنواخت تر شده و بنابراین پستی و بلندیهای نمودار به صورت منظمتری ادامه می یابند. این حالت در نمودار به صورت منظمتری ادامه می یابند. این دیده می شود. همچنین به کمک این تصاویر می توان فاصله تقریبی میان قلهها و حفرهها و همچنین ارتفاع قلهها را نیز اندازه گرفت. همچنین در صورت وجود شکافهای عریض، این نمودارها اندازه گیری عرض و عمق شکافهای از نیز ممکن می سازند.







شکل ۱۹: تصاویر فاز در ابعاد۵×۵ میکرومترالف) M /۳ M و ب) ۸/۵ M.

R



### ۴- نتیجهگیری

فیلمهای نازک اکسید منگنز به کمک روش سل- ژل و استفاده از دو سل اسیدی و بازی بر روی زیر لایههای شیشهای و با تکنیک غوطهوری لایهنشانی شدند. تاثیر افزایش غلظت بر فیلمهای نازک اکسید منگنز به دست آمده از هر دو سل مورد بررسی قرار گرفت. در هر دو سل با افزایش غلظت، گرانروی سلها افزایش یافت و در نتیجه فیلمهایی با ضخامت بالاتر به دست آمد. این افزایش ضخامت سبب کاهش عبور در فیلمها گردید. ضرایب اپتیکی با افزایش ضخامت و کاهش تخلخل، افزایش

می یافت. اگر چه روند تغییر ضرایب اپتیکی در تمام نمونههای به دست آمده از هر دو سل یکی بود، اما مقادیر به دست آمده با توجه به نوع سلها تفاوت آشکاری داشت. تصاویر AFM به دست آمده نیز حاکی از این امر بود که با افزایش غلظت سطح فیلمها یکنواخت تر شده و ترک و شیارها نیز کمتر شدهاند. کاهش حفرهها در سطح نیز با افزایش غلظت به خوبی مشاهده میشود. این مشاهدات به زوبی نتایج اپتیکی به دست آمده را نیز تایید میکند. این ماده علی رغم ویژگیهای منحصر به فردش به دلیل قیمت ماده علی رغم ویژگیهای منحصر به فردش به دلیل قیمت مهم به شمار می آید و در این میان تکنیک سل- ژل یکی مهم به شمار می آید و در این میان تکنیک سل- ژل یکی می باشد.

تنظیم غلظت نقش موثری را در ایجاد خواص اپتیکی بهینه در این فیلمها بازی میکند. به کمک تغییر غلظت در نمونهها میتوان فیلمهایی با ضخامتهای دلخواه و بدون تکرار در دفعات لایهنشانی که کار بسیار دشواری است به دست آورد. همچنین علیرغم افزایش ضخامت در نمونهها میتوان با افزایش غلظت سطحی یکنواختتر و در نتیجه با ضرایب اپتیکی مناسب تری تهیه کرد. بنابراین مطالعه تغییرات غلظت در این ماده یکی از بهترین روشها در تهیه این فیلمها با خواص اپتیکی بهینه میباشد.

# سپاسگزاری

از اسـتاد محتـرم جنـاب آقـای مهنـدس شـریعتی جهـت راهنماییشان سپاسگزاری مینمایم.

# مراجع

- [1] F. Islam, R. Islam, K. A. Ahan, Y. Yamamoto, *Journal of Renewable Energy*, **32**, 2007, 235.
- [2] A. A. Dakhel, Journal of thin solid films, 496, 2006, 353.
- [3] O. Nilsen, H. Fjellvag, A. Kjekshus, *Journal of thin solid films*, **444**, 2003, 44.
- [4] J. Kuei chang, Yi.Lun chen, Wen-Ta. Tasi, *Journal of power source*, **135**, 2004, 344.
- [5] Q. Huang, X. Wang, J. Li, *Journal of Electrochemical*, 147, 2006, 11.
- [6] W.J. Kim, Y.R. Park, Journal of. Crystal Growth, 270, 2004, 162.
- [7] Y. J. Park, J. G. Kim, H. T. Chung, H. G. Kim, *Journal of Solid State Lonics*, **130**, 2000, 203.
- [8] I. Chambouleyron, J. M. Martinez, A. C. Moretti, M. Mulato, *Journal of Applied physics*, **36**, 1997, 8238.

[9] M.F. Kuhaili, Journal of vacuum science Technology, 24, 2006, 1746.